# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-305917

(43)Date of publication of application: 28.10.1992

(51)Int.CI.

H01L 21/027

(21)Application number : 03-094863

(71)Applicant: NIKON CORP

(22)Date of filing:

**02.04.1991** (72)Inventor

(72)Inventor: OZEKI HISAO

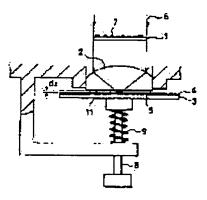
MATSUBARA TAKASHI

#### (54) ADHESION TYPE EXPOSURE DEVICE

### (57)Abstract:

PURPOSE: To thin film thickness of an immersion liquid and reduce the quantity of light absorbed, and to minimize and prevent exposure unevenness in an adhesion type exposure device.

CONSTITUTION: The adhesive surface 11 of an exposure lens is hydrophilic—treated by a hydrophilic solution such as alcohol. A wafer 3 coated with a photoresist 4 is fast stuck on the hydrophilic—treated adhesive surface 11 through an immersion liquid 5, and the pattern 7 of a photomask 1 is transferred onto the wafer 3 by the irradiation of irradiation light 6. Wafer absorbing properties are improved in the hydrophilic—treated adhesive surface 11, and the film thickness of the immersion liquid 5 is made thin.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

### 特開平4-305917

(43)公開日 平成4年(1992)10月28日

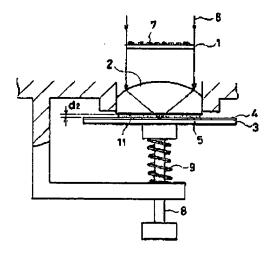
(51) Int CL <sup>5</sup> H 0 1 L 21/027	豫別配号 7	庁內整理番号	F J	技術表示管	沂
		7018-4 <u>M</u> 7352-4M	H01L	21/30 3 4 1 S 3 1 1 A	
				審査請求 未請求 請求項の数1(全 3 日	<b>A</b> )
(21) 出顯語号	特膜平3-94863		(71)出題人	900004112 株式会社ニコン	
(22)出顾日	平成3年(1991)4	月2日		東京都千代田区丸の内3丁目2番3号	
			(72)発明者	大関。尚夫	
				東京都品川区西大井一丁目 6 番 3 号 徐 会社ニコン大井製作所内	式
			(72) 発明者	松原 隆	
				東京都品川区西大井一丁目6番3号	式
			(74)代理人	<b>分理士山川 政省</b>	

### (54) 【発明の名称】 密着型電光装置

#### (57) 【要約】

【目的】 密着型爾光装置において、浸液の膜厚を薄く して光の吸収量を少なくし、露光ムラを軽減防止するこ とを目的とする。

【構成】 観光レンズの密報面11をアルコール等の親水溶液によって親水化処理する。この親水化処理された密若面11にフォトレジスト4を整布されたウエハ3を 侵被5を介して密考させ、照射光6の照射によりフォトマスク1のパターン7をウエハ3上に転写する。 親水化処理された密若面11は、吸水性が向上し、侵被5の膜厚を薄くする。



(2)

特開平4-305917

【特許請求の範囲】

【開求項1】 投影光学系もしくはフォトマスクのウエ ハ密着国を額水化処理し、この額水化処理された密着国 にフォトレジストを協布されたウエハを浸液を介して密 着させ、照射光の照射によりフォトマスクのパターンを 前紀フォトレジストに転写するようにしたことを特徴と する密着型解光装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、LSIの製造工程において、フォトマスク上のパターンをウエハ上に牧影像光する野光裏選、特に依若型蘇光夜蛩に関するものである。

[0002]

【従来の技術】レーザー光等を限射しフォトマスク上のパターンを投影光学系によってシリコンウエハ等の半導体基本上に投影解光するこの種の露光袋間における解光方式としては、①密着(コンタクト)観光方式、②プロキシミティ観光方式、③反射型投影観光方式、③縮小レンズ登影解光方式の4方式が知られている。

【0003】このうち密着露光方式は、フォトマスク (または投影光学系)とウエハとを密着させて露光する もので、これらが完全に番若している場合には、フォト レジスト中の波長が風折率分の1に短くなるため、回訴 の影響が少なく、高解像度の転写が得られるという特色 を有している。しかし、完全な密着を実現することは認めて難しく、またフォトマスクとウエハとを懐頼的に接触させているためにウエハ表面の突起等によりフォトマスクに欠陥が生じ、その寿命を低下させると同時にデバイスの歩留りに影響を及ばすといった問題があった。

【0004】そこで、密着露光方式によるこのような問 魔を解決する方法としてフォトマスクとウエハ間に被体 (浸酸)を充填している。図2は投影光学系にウエハを 密着させた場合を示すもので、1 はフォトマスク、2 は 投影光学系の一部を構成する超光レンズ、3はフォトレ ジスト4が整布されたウエハ、5は庭光レンズ2とウエ ハ3間に充鎖された侵骸、6はフォトマスク1のパター ン?を照射しフォトレジスト4を露光する照射光、8は ウエハ3を保持する保持体、9は保持体8を上方に付勢 しウエハ3を露光レンズ2に押し付ける圧縮コイルばね 40 である。照射光6の波長は短いほど回折の影響が少な く、そのため光源としてエキシマレーザー等のレーザー 装置が用いられる。 浸液 5 としては、 屈折率がフォトレ ジスト4と同程度で光の吸収が少なく、しかもフォトレ ジスト4を溶かさないものが望ましく、通常純水が使用 される。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上途したような授被5を使用した密着整理光線圏においては、 浸液5自身の順厚ムラがあると、浸液5による原射光6 50

の吸収量にムラが生じるため、コンタクト意光されたフォトレジスト4のパターンが前確に露光されている部分とそうでない部分とが全じてしまうという問題があった。したがって、このような露光ムラの発生を防止するため、得被5の襲撃d1を薄くし、光の吸収ムラを少なくすることが望まれている。

2

【0006】本発明は上述したような従来の問題点および要望に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、浸液の膜厚を轉くし、露光ムラを軽減防止し得るようにした密着型感光装置を提供することにある。

[0007]

【課題を祭みするための手段】本発明は上記目的を達成するため、投影光学系もしくはフォトマスクのウエハ密 着面を観水化処理し、この親水化処理された密着面にフォトレジストを塗布されたウエハを浸液を介して密着させ、照射光の照射によりフォトマスクのパターンを前記フォトレジストに転写するようにしたものである。

[8000]

【作用】本発明において、模水化処理された投影光学系 む もしくはフォトマスクのウエハ密着画は、吸水性が向上 し、浸液の膜原を弱くする。

[0009]

【実施例】以下、本発明を図面に示す実施例に基づいて詳細に説明する。図1は本発明に係る痞者型層光接置の一実施例を示す要部の断面図である。なお、図中図2と同一構成部局のものに対しては同一符号を以て示し、その説明を省略する。本実施例は投影光学系にウエハを密若させた場合を示すもので、フォトマスク我影光学系の一様を構成する露光レンズ2のウエハ密着面11を予め 親水化処理し、この親水化処理された密岩面11にウエハ3を施水等の設施5を介して審者させ、照射光6の展射によりフォトマスク1のパターン7をウエハ3上に転写するようにしたものである。

【0010】 飯水化処理は、アルコール系等の額水溶液で密着面11を寄歴に拭き、レンズ表面の汚れを取ることで行なわれる。そして、この親水化処理後密着面11にウエハ3を複接を介して密着させ、ウエハ3を爆光レンズ2にばね9により所定圧にて押しつける。

【0011】かくしてこのような構成においては、親水化処理によって密着面11の吸水性を向上させているので、親水化処理を施さなかったときと比較して浸液5の吸水効果が大きく、したがって、浸液5の表面張力が小さくなって濡れ性が上がるため、浸液5の製厚 d2を図2に示した従来装置と比較して薄くする (d2 < d1) ことができ、また膜原が減くなれば光の吸収量も少なくなるので、これに比例して光の吸収ムラが減少し、軽光ムラを軽減防止することができる。

[0012]

【発明の効果】以上説明したように本発明に係る密着型 露光装置によれば、投影光学系またはフォトマスクのウ

-98-

(3)

特開平4-305917

エハ密着面を親水化処理し、この親水化処理された密着 面に、フォトレジストを整布されたウエハを長波を介し て密着させるように構成したので、民族自身の表面張力 を減らして濡れ性を向上させることができる。したがっ て、浸液の臓厚を薄くするができ、また膜厚が薄くなれ ば没被の誤厚ムラも少なくなるため、光の吸収が少な く、接液による観光ムラを軽減防止することができる。 【図面の簡単な説明】

【四1】本発明に係る修着型蘇光装置の一実施例を示す 要部の断面図である。

【図2】密着型電光装配の従来例を示す妥略の新面図で

**ある**.

### 【符号の説明】

- 1 フォトマスク
- 2 露光レンズ
- ウエハ
- 4 フォトレジスト
- 5 浸液
- 殿射光
- マスク
- 10 11 密着面

